#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出願公開番号

## 特開平11-265520

(43)公開日 平成11年(1999) 9月28日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	•	FΙ					
G11B	7/135			G11	B 7	/135		Z	
•	7/09				7	/09		D	
	7/12				7	/12			
•	7/22				7	/22			
	21/21			:		21/21		E	
			審査請求	未請求	請求項	の数21	OL.	(全 12 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願平10-66489		(71)出	顧人	000005	108		
				ŀ		株式会社日立製作所			
(22)出願日		平成10年(1998) 3月17日		東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地					
				(72)発	明者	伊藤	頤知		
						埼玉県	比企郡	鳩山町赤紹25	20番地 株式会
		. <b>s</b>		ļ	•	社日立	製作所	基礎研究所内	
				(72)発	明者	保坂	純男		
			•			埼玉県	比企郡	鸠山町赤沼25	20番地 株式会
						社日立	製作所	基礎研究所内	
				(72)発	明者	村西	膀		
						茨城県	土浦市	神立町502番地	色 株式会社日
		į	• •	<u> </u>		立製作	所機械	研究所内	-
•				(74) ft	理人	弁理士	小川	勝男	
				1 .					最終頁に続く

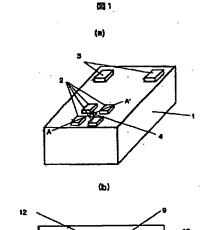
## (54) 【発明の名称】 近接場光ヘッド、近接場光ヘッドの加工方法および光記録再生装置

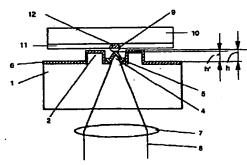
### (57)【要約】

【課題】 記録媒体と光ヘッドの相対速度を大きくでき、かつ小型、軽量で簡略な構成の、近接場光ヘッドおよびそれを用いた光記録再生装置を提供すること。

【解決手段】 スライダ1の上に、スライダ1と情報記録媒体11の接触ないし浮上の状態を制御するために設けられたパッド2と、微小なスポットサイズの近接場光9を発生させるプローブ4が、近接して設けられる。対物レンズで集光された半導体レーザ光は、近接場光発生プローブ4の先端付近で微小なサイズの近接場光9に変換される。スライダは、記録媒体基板10より数10nm浮上して走行し、前記近接場光9により、基板10上に形成された記録媒体11への、情報12の記録、再生が行われる。

【効果】 超高記録密度でかつ転送速度の大きい、小型かつ簡素な構成の光記録再生装置を構成できる。





## 【特許請求の範囲】

【請求項1】情報記録媒体と接触しつつ、またはほぼ一定の間隔を保ちながら相対運動をする光学的に透明なスライダと、前記情報記録媒体と対向する前記スライダの面上に設けられ、前記スライダと前記情報記録媒体の接触または浮上の状態を制御する柱状のパッドと、微小な、スポットサイズの近接場光を発生させる錐体形状のプローブと、を有し、前記パッドと前記プローブが近接して設けられていることを特徴とする近接場光へッド。

【請求項2】前記プローブの高さが、前記パッドの高さより低いことを特徴とする請求項1記載の近接場光へッド。

【請求項3】前記プローブの上に光学的に不透明な薄膜が形成されていることを特徴とする請求項2記載の近接場光へッド。

【請求項4】前記光学的に不透明な薄膜が、金属であることを特徴とする請求項3記載の近接場光ヘッド。

【請求項5】前記パッドが前記プローブを囲むように配置されていることを特徴とする請求項4記載の近接場光へッド。

【請求項6】前記パッドが少なくとも複数の部分に分割されており、分割された部分の間隙を通して、前記プローブが鳥瞰されるように、前記パッドと前記プローブが配置されていることを特徴とする請求項5記載の近接場光へッド。

【請求項7】前記プローブの先端部分に、前記プローブの構成物が露出した開口をさらに有し、前記開口と前記金属薄膜の表面とがほぼ同一平面になっていることを特徴とする請求項5記載の近接場光へッド。

【請求項8】請求項4記載のプローブを加工する近接場 光ヘッドの加工方法において、粒子ビームの照射による エッチングにより錐体構造にプローブを加工することを 特徴とする近接場光ヘッドの加工方法。

【請求項9】請求項4記載のプローブを加工する近接場 光ヘッドの加工方法において、前記薄膜に粒子ビームを 照射しエッチングすることにより、開口を形成すること を特徴とする近接場光ヘッドの加工方法。

【請求項10】請求項4記載の近接場光へッドと、前記近接場光へッドへ照射光を提供する光源と、光記録媒体と、前記近接場光へッドにより発生された近接場光の記録媒体による変調信号を検出する受光手段とを有することを特徴とする光記録再生装置。

【請求項11】請求項10記載の光記録再生装置において、前記プローブへの照射光を集光する手段、前記集光手段によって集光された照明光の焦点位置とプローブ位置のずれを検出する手段、および前記集光手段と前記プローブの相対位置を補正する可動機構を有することを特徴とする光記録再生装置。

【請求項12】請求項11記載の光記録再生装置において、前記集光手段と前記プローブとの相対位置を補正す

る可動機構と前記集光手段とが、光情報記録再生装置を 構成する他の構成要素から分離され、前記集光手段を記 録媒体の所定の位置にアクセスさせる可動機構上に搭載 されていることを特徴とする光記録再生装置。

【請求項13】情報記録媒体と相対運動をする光学的に透明なスライダと、前記情報記録媒体と前記スライダとの間隔を制御するパッドと、近接場光を発生する錐体形状のプローブと、を有し、前記パッドと前記プローブは前記情報記録媒体と対向する前記スライダの面上に接近して設けられていることを特徴とする近接場光へッド。 【請求項14】前記プローブの高さが、前記パッドの高さより低いことを特徴とする請求項13記載の近接場光へッド。

【請求項15】前記プローブの上に光学的に不透明な薄膜が形成されていることを特徴とする請求項14記載の近接場光へッド。

【請求項16】前記光学的に不透明な薄膜が、金属であることを特徴とする請求項15記載の近接場光へッド。 【請求項17】前記パッドが前記プローブを囲むように配置されていることを特徴とする請求項16記載の近接場光へッド。

【請求項18】前記パッドが少なくとも複数の部分に分割されており、分割された部分の間隙を通して、前記プローブが鳥瞰されるように、前記パッドと前記プローブが配置されていることを特徴とする請求項17記載の近接場光へッド。

【請求項19】前記プローブの先端部分に、前記プローブの構成物が露出した開口をさらに有し、前記開口と前記金属薄膜の表面とがほぼ同一平面になっていることを特徴とする請求項17記載の近接場光ヘッド。

【請求項20】情報記録媒体と相対運動をする光学的に透明なスライダと、前記スライダと前記情報記録媒体との間隔を制御する柱状の複数のパッドと、微小なスポットサイズの近接場光を発生する錐体形状のプローブとを有し、前記プローブが前記パッドの間に位置するように前記パッドと前記プローブが前記情報記録媒体と対向する前記スライダの面上に設けられていることを特徴とする近接場光へッド。

【請求項21】情報記録媒体と相互運動をする光学的に透明な物質からなるスライダと、前記スライダと前記情報記録媒体との間隔を制御するパッドと、レーザ光を前記プローブに集光するレンズと、前記レンズにより集光されたレーザ光により近接場光を発生する錐体形状のプローブと、前記プローブをコーティングする金属薄膜と、前記情報記録媒体に対向する前記パッドの面に形成された摩耗防止薄膜と、を有し、前記パッドは4つに分割され、分割されたパットの中央に前記プローブが設けられていることを特徴とする近接場光へッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、近接場光ヘッド、近接場光ヘッドの加工方法、および光情報処理装置に関し、特に超高記録密度でかつ転送速度を大きくするのに適した近接場光ヘッド、近接場光ヘッドの加工方法、および光情報処理装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】光ディスク装置の高密度化を達成する方 法として近年、近接場光を応用した光記録が注目されて いる。例えば、アプライド・フィジクス・レターズ、6 1巻、2号の142頁から144頁 (Applied Physics Lettes, Vol. 62, No. 2, pp. 142-144, 1992) に記載されてい るように、光ファイバの先端をコーン状に加工し、その 先端の数10 nmの領域以外を金属の被膜で覆ったプロ ーブを作製し、これをピエゾ素子を用いた精密アクチュ エータに搭載して位置を制御して、直径60nmの記録 マークをプラチナノコバルトの多層膜上に記録再生した 例が報告されている。この例の場合、プローブと記録媒 体の距離制御には、原子間力を応用したシア・フォース 方式が用いられ、記録密度は45ギガビット/平方イン チに達し、現状の約20倍とすることができる。更に特 開平3-171434号公報では、微小なピンホールに レンズで光を集光して近接場光を発生するとともに、前 記微細ピンホールを先端に形成したカンチレバーと記録 媒体の間に発生する原子間力を用いて前記微小ピンホー ルと記録媒体の間の距離を制御する方法、および媒体の 上に光源、レンズ、微小ピンホールを収納したスライダ を配置し、スライダをエア浮上させ、微小ピンホールと 記録媒体の間の距離を制御する方法が考案されている。 [0003]

【発明が解決しようとする課題】光情報記録再生装置に おいては、情報の転送速度を大きくするため、記録媒体 と情報を記録再生する光ヘッドの相対速度を大きくする 必要がある。

【0004】しかし、プローブと記録媒体の距離制御に原子間力を応用したシア・フォース方式を応用した上記第一の従来例では、記録媒体と光ヘッド、すなわちファイバプローブとの距離をスキャニング・フォース顕微鏡を用いて、極めて精密に制御する必要があるため、情報を記録したディスクを高速に回転した場合、ディスクの個心によって生じる高い周波数の基板とプローブの距離の変動を制御しきれず、転送速度をあげることができないという問題がある。

【0005】また、カンチレバーを応用した従来例では、カンチレバーの変位の検出方法としてキャパシタンスの変化やレーザ干渉計測が用いられており、近接場を発生させる照射光学系とは別の大がかりな光学系ないしキャパシタンス測定系を必要とし、装置が大型化、複雑化するという問題があった。また、アプライド・フィジクス・レターズ、68巻、25号の3531頁から35

33頁(AppliedPhysics Lettes, Vol. 68, No. 25, pp. 3531-3533, 1996)の例では、カンチレバーの変位の検出方法として、カンチレバーの背面にレーザ光を照射し、カンチレバーの変位をリニアフォトダイオード上の光点の移動に変換して検知する光てこ方式が用いられているが、この場合も、近接場を発生させる照射光学系とは別の大がかりな光学系を必要とし、装置が大型化、複雑化するという問題があった。

【0006】また、媒体の上に光源、レンズ、微小ピンホールを収納したスライダを配置する従来例では、スライダ上に光源、レンズなどの多くの光学部品が搭載されている。このため、スライダの質量が増加し、記録媒体の回転に伴う上下振動への追従性能が劣化し、装置の構築が不可能になってしまう。さらに、前記特開平3-171434号公報には、具体的なピンホール、レーザ光源、レンズの搭載、形成方法が開示されていない。

【0007】本発明の目的は、近接場光発生用プローブを応用した超高密度光記録再生速度の、情報の転送速度を大きくするため、記録媒体と情報を記録再生する光へッドの相対速度を大きくすることが可能で、かつ記録媒体と光へッドの距離を検出するための付加的な設備が不用の、小型、軽量で簡略な構成の近接場光へッド、およびそれを用いた光記録再生装置を提供することにある。【0008】

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため に、以下の手段を採用した。

【0009】情報記録媒体と接触しつつ、もしくはほぼ 一定の間隔を保って浮上しながら相対運動をする光学的 に透明なスライダ上の、前記情報記録媒体と対向する面 上に、前記スライダと前記情報記録媒体の接触ないし浮 上の状態を制御するために設けられた円柱ないし角柱形 状のパッドと、微小なスポットサイズの近接場光を発生 させるプローブを近接して設け、さらに、前記パッドと 前記プローブの、スライダの前記情報記録媒体と対向す る面からの高さが略等しく、かつ前記プローブの前記情 報記録媒体と対向する面からの高さが前記パッドの前記 情報記録媒体と対向する面からの高さより小さくする。 これにより、近接場ヘッドがスライダと一体形成され、 従来の磁気ディスク装置で用いられているヘッドと同様 の性能をもった、小型、軽量、簡略な構成の近接場光へ ッドが構成できる。また、スライダが小型、軽量となる ため、記録媒体と情報を記録再生する光ヘッドの相対速 度を大きくすることが可能となる。

【0010】さらに、前記近接場光ヘッドにおいて、前記パッドと前記プローブ上に光学的に不透明な薄膜、例えば金属薄膜を形成したり、さらにまた、前記プローブの先端部分において、前記プローブを構成する物体が露出している構造を有し、かつ前記プローブの露出している部分の表面と、前記金属薄膜の表面とが、実質的に同

一平面になる微小開口を作製することにより、微小なサイズの近接場光を発生させることができるようにする。 【0011】さらに、前記近接場光へッドにおいて、前記パッド部を、前記プローブを囲むように配置し、さらにまた前記パッド部を少なくとも複数の部分に分割し、パッド側面より、分割された部分の間隙を通して、前記、プローブを鳥瞰することが可能なように配置することにより、側面から粒子ビームを照射しエッチングすることで、プローブ形状を任意の錐体構造に加工したり、微小開口を作製することを可能とする。

【0012】さらに、前記近接場光ヘッドと、前記近接場光ヘッドへの照明光を提供する光源と、光記録媒体と、前記近接場光ヘッドにより発生された近接場光の記録媒体による変調信号を検出する受光手段を用いて、超高密度の光記録再生装置を構成することができる。 【0013】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を図面を用いて説明する。

【0014】図1は本発明の一実施例であり、図1(a) は本発明の近接場光ヘッドの斜視図、図1(b)は、図 1(a)のAAにそった断面図である。

【0015】図1(a)において、1は光学的に透明な物 質からなるスライダである。本実施例では、波長780 nmの半導体レーザを光源とする場合について説明する ので、スライダの材質は石英を選択したが、これに限定 されるものではない。2から3はスライダと情報記録媒 体11の浮上の状態を制御するために設けられたパッド である。本実施例では、スライダ底面に3つのパッドが 設けられている。そのうちの一つのパッド2は、4つに 分割されており、その中央に近接場光発生用の四角錐形 のプローブ4が設けられている。プローブ4には、図1 (b) に示されているように厚さ数10 nmの金属薄膜 5がコーティングされている。また、パッド2から3及 びそれ以外のスライダの記録媒体に対向する面には、摩 耗防止用の薄膜、例えばカーボン膜6がに約10 n m程 度成膜されている。図1(b)において、7は半導体レ ーザ光8を近接場光発生用プローブ4に集光するための 対物レンズである。集光された半導体レーザ光8は、近 接場光発生プローブ4の先端付近で微小なサイズの近接 場光9に変換される。スライダは、記録媒体基板10よ り数10 nm浮上して走行し、前記近接場光9により、 基板10上に形成された記録媒体11への、情報12の 記録、再生が行われる。

【0016】ここで、プローブ5の高さhは、必ずパッド2の高さhより小さくされなければならない。図1(b)で示したように、スライダは記録媒体基板11より、わずか数10nm浮上して走行する。パッド2の上面は、スライダと記録媒体基板11との摺動面にあたる。このため、本ヘッドによる記録再生動作中に、スライダと記録媒体基板が接触する状況が発生した場合、パ

ッド上面が記録媒体基板と接触する。このとき、プロー ブ4の高さhがパッド2の高さhより大きいと、プロー ブ先端と記録媒体基板が接触し、プローブの摩耗を招 く。これを防止するため、hはhより必ず小さくする必要 がある。hをhより小さくするのみならず、hとhの差も 極めて小さくする必要がある。近接場光9の強度は、プ ローブ先端からの距離がプローブ先端のサイズ程度まで は大きく変化しないが、プローブ先端からの距離がそれ 以上に大きくなると、急激に減少することが知られてい る。本実施例の場合のプローブ先端のサイズは数10か ら100nmであり、もし、プローブと媒体の距離がそ れ以上大きくなった場合、近接場光10の強度が記録媒 体11上で極めて小さくなってしまう。 スライダは記録 媒体表面から数10mm浮上して走行するため、もし、 プローブと媒体の距離をプローブ先端のサイズ、すなわ ち数10から100nm以下に保つためには、hとhをほ ぼ同じとし、スライダ走行時に、プローブ先端と記録媒 体表面との距離も数10 nm程度に保つ必要がある。こ のためにはhとhの差をnmオーダーで制御しなければな らない。この点が、本近接場光ヘッド作製の大きなポイ ントであり、作製方法については、後で詳述する。

【0017】以上のような、近接場発生用プローブがスライダと一体形成された近接場光ヘッドを用いれば、従来の磁気ディスク装置で用いられているヘッドと同様の性能をもった、小型、軽量、簡略な構成の近接場光ヘッドが構成できる。かつ、スライダが小型、軽量となるため、記録媒体と情報を記録再生する光ヘッドの相対速度を大きくでき、情報の転送速度を向上することが可能となる

【0018】次に、本実施例で用いられている近接場光 発生用プローブについて、図2から図6を用いて詳述する。

【0019】図2(a)は、図1で用いられていた四角錐形状のプローブの拡大図、図2(b)は三角柱状のプローブの拡大図である。また、図2(c)は、図2(a)において四角錐の頂点を通り底面の2つの辺の中点B、Bを通る面(半導体レーザ光8の偏光方向と平行)、および図2(b)において、三角柱の3つの辺の中点C、C、Cを通る面(半導体レーザ光8の偏光方向と平行)における断面図をあらわしている。

【0020】図2(a)において、例えば、プローブ4が石英で形成されている場合、プローブ4上に形成されている金属薄膜5は、様々な種類のものが選択可能である。ただし、金属の種類と、図2(c)で示された四角錐の頂角の半角の間に、ある特定の関係がある場合、高い効率が得られる。半導体レーザ光8は、プローブ4の先端付近に集光されており、その波面はほぼ平面とみなせる。この場合、上記の角のと金属の種類を適当に組み合わせると、金属薄膜5内に表面プラズマ波16が励振される。表面プラズマ波は数十ヵmの薄い金属膜の中

でも伝播可能であり、表面プラズマ波に変換された半導体レーザ光は効率よくプローブ先端まで伝播し、高い効率で近接場光9を発生せしめることができる。例えば、プローブとして石英を用いると、金属としてアルミニウムを用いる場合のは約42度、金を用いる場合のは約44度、銀を用いる場合のは約44度とする。図2(b)では、プローブ13の形状が三角柱であるため、プローブ先端付近に集められた光は断面CCCに平行な面内のみで集光される。ことため、図2(a)の場合とことなり、緑状の近接場光15が発生する。図2(b)のような形状の場合も、その頂角の半角のと金属14の種類の関係を、上記で説明したのと同様に設定すれば、高い効率が得られる。

【0021】プローブ4、13のサイズは特に限定されるものではないが、作製が容易であること、また、例えば、波長780nmのレーザ光8を、開口数0.6の対物レンズ7で集光した場合、その集光スポットが約1.3μmであることを考慮し、すべてのレーザ光が有効にプローブに集光されることを考えると、例えば、図2(a)の場合は四角錐底面の正方形の一辺を3から4μmとするのが望ましい。また、図2(b)の場合は、断面CCCに平行な2辺の長さは3から4μm程度とすることが望ましいが、断面CCCと垂直な2辺は、近接場光15のスポットサイズによって様々な値を選択する。

【0022】図3は、プローブ17が円錐形状の場合の例である。この場合も円錐の頂角の半角  $\theta$ とプローブ上に成膜される金属18の種類の関係が、上記のような特定の条件を満足すれば、高い効率で近接場光10を発生することが可能である。

【0023】図4は、近接場光発生用プローブの別の例である。図4(a)は、図2(a)で示された四角錐形状のプローブ5の先端部分が切除されたプローブ、図4(b)は図2(b)で示された三角柱形状13の先端部分が切除されたプローブ、図4(c)は、図4(a)において四角錐台の上面の四角形の二辺の中点D、Dおよび下面の四角形の二辺の中点D、Dおよび下面の四角形の二辺の中点D、Dの4点を通る面(半導体レーザ光8の偏光方向と平行)、および図4(b)において、プローブ上面の上面の四角形の二辺の中点E、Eおよび下面の四角形の二辺の中点E、Eおよび下面の四角形の二辺の中点E、Eおよび下面の四角形の二辺の中点E、Eの4点を通る面(半導体レーザ光8の偏光方向と平行)における断面図をあらわしている。

【0024】図4(a)において、プローブ19は四角錐の先端が切除され、開口21が形成されている。開口が形成されているでは、プローブ表面に形成された光学的に不透明な薄膜20、例えば金属膜が、対物レンズで集光された半導体レーザ光8の遮光膜として用いられる。この場合、記録再生に用いられる近接場光22のサイズは、開口21の大きさはに金属膜への光のしみこみ深さを加えたものになる。後で詳述する加工法を用いると、最小で大きさ約20nmの開口が形成で

李、松子、张安、一切,但因此以及对发表,在这个概念。

きる。遮光用の金属としては金、銀、白金、アルミニウム、クロムなどさまざまの金属が用いられる。これらの金属への波長780nmの光のしみこみ深さは、典型的には10から20nmであり、以上から、最小約40nmの近接場光スポットが形成可能である。図4(b)では、プローブ23の形状が三角柱であり、開口25の形状も細長い長方形であるため、線状の近接場光26が発生する。この場合、断面EEEE内の近接場光のサイズは、図4(a)の場合と同じであるが、断面EEEEと垂直方向のサイズは、長方形の長い方の辺の長さを選択することにより、自由に選択可能である。

【0025】図4(c)で示されたプローブの頂角ゆの値は、ほぼ30から60度程度とすると、高い透過効率のプローブが得られる。ゆが小さすぎると、プローブのテーパ部分の長さが大きくなる。一般に空間を伝播する光は、光の波長程度の大きさより小さい領域では伝播することができず、図4(c)の例では、多くの光パワーが金属膜20ないし24に吸収されてしまう。このため、透過効率が小さくなる。一方ゆが大きくなりすぎると、ほとんどの光はプローブから反射されてしまう。したがって、ゆの値は、金属膜への光の漏れ出しを押え、かつ反射を押さえるため、上記の適当な値の範囲にすることが望ましい。

【0026】プローブ19、23のサイズは特に限定されるものではないが、作製が容易であること、また、例えば、波長780nmのレーザ光8を、開口数0.6の対物レンズ7で集光した場合、その集光スポットが約1.3 $\mu$ mであることを考慮し、すべてのレーザ光が有効にプローブに集光されることを考えると、例えば、図4(a)の場合は四角錐底面の正方形の一辺を3から4 $\mu$ mとするのが望ましい。また、図4(b)の場合は、断面EEEEに平行な2辺の長さは3から4 $\mu$ m程度とすることが望ましいが、断面EEEEと垂直な2辺は、上記で述べたように、近接場光26のスポットサイズによって様々な値を選択する。

【0027】図5は、プローブ27が円錐形状であり、かつ頂点近傍が切除され、円形の開口29が形成されているの場合の例である。この場合においても、近接場光30のサイズは、開口29の大きさに遮光膜28への光のしみこみ深さを加えたものとなり、最小40nm程度のサイズとすることが可能である。また、円錐の頂角の半角φの大きさは、前述した図4(c)の場合と同様、30から60度程度とすると、高い透過効率を得ることができる。

【0028】プローブ19、23、27のような開口を有するプローブの場合、さらなる高い透過効率を得る研究が、光ファイバを化学エッチングして作製されたプローブに関して行われている。例えば、アプライド・フィジクス・レターズ、第69巻、1.9号の2612頁から2614頁(Applied physics Letters, Vol.69, No.19,

pp.2612-2614,1996)には、図6(b)のごとく、プロ ーブ31の頂角を2段階に変え、根元の部分の頂角は小 さく、先端の部分の頂角は大きくすることで、金属膜3 2への光の漏れ出しを押え、かつプローブ31からの反 射を押さえ、透過効率の高いプローブを得ることができ ることが記載されている。本発明においても、後述する。 加工法を用いれば、容易に図6(b)のような、透過効 率の高いプローブを得ることができる。また、アプライ ド・フィジクス・レターズ、第71巻、13号の175 6頁から1758頁(Applied physics Letters, Vol.7 1,No.13, pp.1756-1758,1997)には、図6:(c)のごと く、プローブ35の形状を、プローブの中心線に対して 非対称にし、表面プラズマ波を励振することによって、 透過効率の高いプローブを得ることができることが記載 されている。本発明においても、後述する加工法を用い れば、容易に図6(c)のような、透過効率の高いプロ ーブを得ることができる。

【0029】図7は、接触型スライダを応用した本発明の第二の実施例である。図7(a)は本実施例の近接場光へッドの斜視図、図7(b)は、図7(a)のFFにそった断面図である。

【0030】図7(a)において、光学的に透明な物質か らなるスライダ1上には、スライダ1と情報記録媒体1 1の接触状態を制御するために設けられたパッド2が設 けられている。図1の実施例では、スライダ底面に3つ のパッドが設けられていたが、本実施例では、4つに分 割されたパッド2のみが設けられている。パッド2の中 央に近接場光発生用の四角錐形のプローブ4が設けられ ている。プローブ4には、図7(b)に示されているよ うに厚さ数10nmの金属薄膜5がコーティングされて いる。また、パッド2及びそれ以外のスライダの記録媒 体に対向する面には、摩耗防止用の薄膜、例えばカーボ ン膜6がに約10nm程度成膜されている。図7(b) では、金属薄膜5と摩耗防止用の薄膜6として別々の材 料を用いる例を示したが、耐摩耗性と、開口がない図2 から3の項で述べたプローブの場合は表面プラズマ波の 励振特性と、また開口を有する図4から6の項で述べた からプローブの場合は遮光特性の両方を満足できる材 料、例えばクロム膜で、スライダ底面およびプローブ表 面を覆うことも可能である。そうすれば、作製プロセス は一層容易になる。記録媒体表面には、摩耗防止用のカ ーボン膜39が数nm成膜され、その上に高分子の潤滑 剤がやはり数nm塗布されている。このカーボン膜と潤 滑剤により、記録媒体11の耐摩耗性が向上させられて いる。スライダ1は、記録媒体基板10に接触しながら 走行し、前記近接場光9により、基板10上に形成され た記録媒体11への、情報12の記録、再生が行われ

【0031】図8は、浮上型スライダを用いた本発明の 第三の実施例である。図8(a)は本実施例の近接場光へ ッドの斜視図、図8 (b) は、図8 (a) のGG にそった 断面図である。

【0032】図8(a)において、光学的に透明な物質か らなるスライダ1上に、スライダと情報記録媒体11の 浮上の状態を制御するために設けられたパッド2、3が 設けられている。本実施例では、スライダ底面に3つの パッドが設けられている。そのうちの一つのパッド2 は、4つに分割されており、その中央に近接場光発生用 の四角錐形のプローブ4が設けられている。本実施例に おいては、パッド2に設けられた4つの分割された小パ ッドの高さは、パッド2全体およびパッド3のスライダ 底面からの高さより小さく設計されている。このように することにより、プローブ4のサイズの如何によらず、 自由にスライダ底面からパッド上面までの高さを設計す ることができる。これにより、スライダの浮上量を、任 意に設定することができる。また、パッド2に設けられ た4つの分割された小パッドの高さは、実施例1と同じ ように、プローブ4の高さより僅かに高く設定する。ス ライダの浮上量を考慮することなく、プローブの形状、 サイズに応じて自由に小パッドの高さが設定できるの で、プローブ作製の自由度が大きくなる。

【0033】上記実施例2および3では、プローブとして、図2(a)の形状のものを例にとって説明したが、図2から図6に示された、その他のすべてのプローブ形状に関しても、全く同様に実施例2および3のスライダ形状が適用できる。

【0034】図9および図10は、図1から図8に示された、近接場光ヘッドの作製工程を示した図である。

【0035】まず、図9(a)のように、基板1上に、フ オトレジスト40を塗布、露光、現像して、パッド2、 3、およびプローブ4を作製する部分のみをマスクとし て残す。次に、図9(b)のように、図9(a)で形成さ れたマスクパターンを、例えばアルゴンガスを用いたド ライエッチングにより、基板1へ転写する。次に、図9 (c) のように、フォトレジスト40を除去した後、ス ライダ底面およびパッド面を保護する保護膜6を、スパ ッタリング法などにより成膜する。次に、図9(d)の ように、集束イオンビーム (Focused Ion Beam:以下F IBと略称する) 41を用いたエッチングにより、プロ ーブを所定の形に加工する。FIB加工においては、例 えばガリウムイオンを用いる場合、加速電圧を数十k V、ビーム電流を数10pA程度とする。このときのF IB41の集束位置におけるビームサイズは、数10n mであり、本発明のプローブを作製するのに十分の分解 能である。 FIB加工においては、加工すべきサンプ ルにイオンを照射しながら、放出する2次電子像をと り、得られた2次電子像を見ながら、自由にイオンを照 射する位置を制御することができるので、多様な加工 が、短時間で、かつ容易に行うことができる。上記プロ ーブの加工では、まず基板の一側面から、パッド2の間 を通してイオンをプローブへ加工すべき中央の突起へ照 射しながらエッチングを行う。これにより、中央の突起 の形は直方体から、三角柱の形状に加工される。プロー ブ13や23を作製する場合は、これで加工が終わりで ある。プローブ4など、四角錐形状のプローブを作製す る場合は、基板をプローブの中心軸に平行な軸のまわり、 で90度回転させ、最初のエッチングの際のビームの方 向と90度をなす方向から、再びパッド2の間を通して イオンを照射しながら、エッチングを行い、最終的に錐 体の形状に加工する。この際の全加工時間は基板の材質 にもよるが、10分程度である。このような、基板側面 からのFIB加工を応用してプローブを作製することに より、パッドの高さとプローブの高さはおおむね等し く、かつプローブの高さがパッドの高さより僅かに小さ く加工できる。FIB加工の後、図9(e)のように、パ ッドおよびその他のスライダ底面をフォトレジスト40 で覆い、プローブのまわりのみを露出させ、プローブ上 に金属膜5を成膜する。最後にリフトオフ法により、パ ッドおよびその他のスライダ底面上に成膜された金属を 除去し、図9(f)にような、近接場光ヘッドの作製を 完了する。

【0036】さらに、図4から6で示された開口を有す るプローブを作製する場合は、図10のように、完成し た図9 (f)の状態のプローブに、再度側面からFIB 4.1を照射し、先端部分を切除する。開口の大きさの大 小は、図10に示した切りこみ量を制御することによ り、自由に変えることができる。また、本方法によれ ば、図10に示したごとく、切除されたプローブの先端 は平坦となり、その高さはパッドの高さを越えることが ない。したがって、プローブ先端が記録媒体11と衝突 して破損することがなく、信頼性を高めることができ る。また、図6(b)、(c)に示された特殊な形状の プローブを作製する場合は、図9(d)のFIB加工の 際に、形状に応じてビーム位置を制御しながらエッチン グを行う。このように、任意のプローブ形状を短い加工 時間で形成できることが、FIBを用いた本加工法の大 きな効果である。

【0037】図11は、本発明の近接場光ペッドを応用した光記録再生装置の斜視図である。記録媒体基板10 および記録媒体膜11からなるディスク43は、ペース42に固定されたスピンドルモータに連結された軸44 に取り付けられて回転する。この回転運動により図2から8のいずれかの近接場光ペッドを搭載したスライダ1 に対し、相対運動をする。スライダ1の位置決めを行うアクチュエータ49も、ベース42に固定されおり、その可動部48には、アーム50およびサスペンション52が取り付けられている。可動部48は、その中心軸の周りを回転し、サスペンション52の先端に取り付けられたスライダを、ディスク43の半径方向に移動させる。さらに、トラッキングピッチが小さいディスクを用

. .

いる場合には、アーム50の先端部に、アクチュエータ 49より、さらに微細な位置決めを可能とするアクチェ ータ51を取り付ける。ベース42に固定されたインタ ーフェース45には、コネクタ46が接続され、コネク タ46に接続されたケーブルを通して、本装置を駆動す るための電源の供給、装置に対する記録再生命令、記録 情報の入力、再生情報の出力を行う。近接場光ヘッドへ のレーザ光の供給、および記録情報の検出、スライダの トラックからの位置ずれ情報の検出、および対物レンズ とスライダの位置ずれの検出は、詳細は図12で説明す るが、ベースに固定された光学ヘッド53を用いて行わ れる。スライダの直下には、ガルバノミラー、対物レン ズ、および対物レンズを移動させるアクチュエータを搭 載した可動部分54が設置されている。図11には陽に は記載されていないが、可動部分54は、可動部分全体 を移動させるアクチュエータにより、ディスク43の半 径方向に、スライダ1に追従して移動させられる。

【0038】次に、図12を用いて、上記光ヘッド5 3、および可動部分54の動作について詳細に説明す る。半導体レーザ55によって発生されたレーザ光は、 コリメートレンズ56により平行ビームに変えられたの ち、ビームスプリッタ57を通過し、ガルバノミラー5 8で方向を変えられる。ガルバノミラー58で方向を変 えられたレーザ光は、プローブ4上に対物レンズ7によ って集光され、近接場光が発生させられ、ディスク43 上に形成された記録媒体への記録、再生が行われる。以 下、プローブとして図2(a)に示されたプローブ4(お よびそれを搭載するスライダ1)を例にとって説明する が、図2から図8に記載されたどのプローブ(およびそ れを搭載するスライダ)を用いても、以下の内容は全く 同じである。記録媒体の情報により強度を変調されたレ ーザ光は、対物レンズ7を通り、ガルバノミラー58で 再び方向を変えられ、ビームスプリッタ57で反射し、 検出系に導かれる。検出系では、読み出し信号の検出、 および対物レンズ7によって集光されたレーザ光の焦点 とプローブ4の光軸方向の位置ずれの検出と、光軸と垂 直方向の位置ずれの検出が行われる。光軸と垂直方向の レーザ光焦点とプローブ4の位置すれは、レンズ60に より集光され、ビームスプリッタ61によ分割されたレ ーザ光を、一方向のみに集光するレンズ、例えばシリン ドリカルレンズ63により4分割光検出器64上へ集光 し、いわゆる非点収差法と呼ばれる焦点誤差検出方式を 用いて行う。レーザ光の焦点とプローブ4の光軸と垂直 方向のずれの検出は、4分割光検出器62により以下の ように行う。レーザ光の焦点が、プローブ4とディスク 43の半径方向に位置ずれすると、4分割光検出器の検 出器Aと検出器Cの和信号と、検出器Bと検出器Dの和 信号にアンバランスが生じる。したがってこれらの和信 号の差を用いれば、位置ずれを検出できる。一方、レー ザ光の焦点が、プローブ4とディスク43の周方向にず れると、4分割光検出器の検出器Aと検出器Bの和信号 と、検出器Cと検出器Dの和信号にアンバランスが生じ る。したがってこれらの和信号の差を用いれば、位置ず れを検出できる。これらの位置ずれ信号を用い、例え ば、対物レンズの周りに取り付けられた2次元アクチュ エータ59によりレーザ光の焦点とプローブ4の光軸方, 向の位置ずれおよびディスク43の周方向の位置ずれ を、ガルバノミラー58に取り付けられたミラー58の 傾きを移動させるアクチュエータにより、レーザ光の焦 点とプローブ4のディスク43の半径方向の位置ずれを 補正することにより、つねに対物レンズの焦点をプロー ブ4に合わせ、効率よく近接場光を発生せしめることが できる。最後に、記録情報の再生は、例えば、ディスク 上に形成された記録媒体として、いわゆる相変化型の記 録媒体や再生専用の凹凸記録媒体を用いる場合は、2つ の4分割検出器62、64のすべての検出器の和信号の 強度を用いて行う。

【0039】次に、本発明における位置決め、サーボ技 術について図13を用いて説明する。図13において、 65から71は、ディスク上に設けられた多くの情報ト ラックのうちの7本を示している。72は、トラック番 号を識別するアドレスマーク群であり、トラック毎に異 なっており、このマークによってプローブ4がどのトラ ック上に位置するかを検知する。各トラックには、ウォ ブルマーク73とクロックマーク74が設けられてい る。情報の記録再生の際、プローブ4は図13におい て、図の下から上に移動する。プローブ4は、クロック マーク74を通りクロックが作成された後、ウォブルマ ーク73上を通過する。もしプローブの位置がトラック 中心からずれていた場合、連続した2つのウォブルマー クからの信号にアンバランスが生じ、これらの信号の差 をとってトラッキング誤差信号とする。この誤差信号に 応じてアクチュエータ49(もし取り付けられていれば アクチュエータ51も)を駆動し、プローブ4をトラッ ク中心に位置合わせする。対物レンズ7は、前述のよう に常にプローブ4上にレーザ光の焦点が位置するように 動作するので、レーザ光の焦点も上記のサーボ動作に追 従してサーボされる。プローブ4は、ウォブルマーク7 3の上を通過した後、アドレスマーク72上を通過し、 情報を記録する記録部75上へ入り、情報の記録再生が 行われる。

【0040】次に、プローブ4を目的のトラックまで移動させるシーク動作について述べる。シーク動作においては、図11のシステムコントローラ47から、外部の制御装置から指定された情報を記録、再生すべき位置と、4分割光検出器62、64によって検出された実際のプローブ4の位置を比較する。この比較結果を基に、位置決めアクチュエータ49(もし取り付けられていればアクチュエータ51も)を駆動し、プローブ4をディスク上の所定のトラックに位置決めする。このとき、対

物レンズ7は、レーザ光の焦点位置とプローブ4の位置が、光軸方向、および光軸と垂直な平面内でかつディスクの周方向にずれないよう、アクチュエータ59でサーボされながら、かつ、図12には陽には記載されていないが、可動部54全体をディスクの半径方向に移動させるアクチュエータにより、プローブを搭載したスライダ1に追従して移動させられる。スライダ1および可動部54は極めて軽量であり、このためシークに要する時間を、通常の磁気ディスク装置並みに短くすることができる。

【0041】図14は、本発明の他の実施例を示す図で ある。図14(a)は、対物レンズ76が、スライダ1上 に集積されたれた例である。レンズ76としては、通常 の曲面形状のレンズの他、フレネルレンズなどの回折格 子を応用したレンズを用いることができる。図14 (b)は、対物レンズ78の他、半導体レーザ77、光 検出器79がスライダ1上に搭載された例である。この 場合、対物レンズ78としてフレネルレンズなど回折格 子を用いた平面レンズを、半導体レーザとしては面発光 レーザを用いると、装置が非常に小型になる。図14 (b)の例では、レーザ光の焦点とプローブ4の相互の 位置合わせは全く不要となり、図11、図12に記載さ れた光ヘッド部53、54は不要となる。このような構 成にすれば、装置構成は、現状の磁気ディスク装置と全 く同様の構成となり、極めて薄型、小型の光記録再生装 置を構成できる。

【0042】図15は、本は発明のさらに他の実施例を 示す図である。これまでの例では、情報の検出を、プロ ーブからの反射光を用いて行う例を示したが、図15 は、ディスクからの透過光を用いる例を示している。情 報12からの再生信号は、対物レンズ80により検出器 82上に集光される。光記録媒体11として光磁気記録 媒体を用いる場合は、さらに検出器82の前に、透過光 の偏光方向を制御する素子81を挿入し、検出を行う。 【0043】以上においては、スライダ1の底面に3つ のパッドが設けられ、そのうちの一つのパッド2は、4 つに分割されており、その中央に近接場光発生用の四角 錐形のプローブ4が設けられている例を説明してきた が。図16のように、さらに簡単な構成とすることも可 能である。図16(a)において、スライダ1の底面に3 つのパッド2が設けられている。 そのうちのひとつのパ ッドの内側に近接して、近接場光発生用の四角錐形のプ ローブ4が設けられている。プローブ4としては、図2 から図6に示されたいずれの形状のプローブを用いるこ とが可能である。また、図16では、図1に対応する浮 <u>上型</u>のスライダの例を示したが、 図7の接触型スライダ を用いることも可能である。 図16(b)においては、図 8のごとく、近接場光発生用のプローブ4が近接して設 置されたバッド83と近接場光発生用のプローブ4がひ とつの共通の土台上84に形成され、パッド83の高さ

は、ほかのパッドパッド3のスライダ底面からの高さより小さく設計されている例である。これらの例では、スライダの構造が簡単であり、その作製がより容易になるという利点がある。

#### [0044]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、情報の転り送速度を大きくするため、記録媒体と情報を記録再生する光へッドの相対速度を大きくすることが可能で、かつ記録媒体と光へッドの距離を検出するための付加的な設備が不用の、小型、軽量で簡略な構成の、近接場光へッドおよびそれを用いた光記録再生装置を提供することが可能となる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の近接場光ヘッドの実施例を示す図であり、(a)は斜視図、(b)は断面図。

【図2】近接場光ヘッドで用いられているプローブの一例を表す図であり、(a)、(b)は斜視図、(c)は断面図、

【図3】近接場光ヘッドで用いられているプローブの他の一例を表す斜視図。

【図4】近接場光ヘッドで用いられているプローブの他の一例を表す図であり、(a)、(b)は斜視図、(c)は断面図。

【図5】近接場光ヘッドで用いられているプローブの他 の一例を表す斜視図。

【図6】本発明で用いる半導体レーザプローブを表す断 面図。

【図7】接触型スライダを用いた本発明の第2の実施例を示す図であり、(a)は斜視図、(b)は断面図。

【図8】本発明の第3の実施例を示す図であり、(a)は 斜視図、(b)は断面図。

【図9】図1から図8までに示された種々の近接場光へッドの作製工程を示す図。

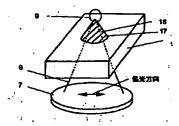
【図10】図5、6の近接場光へッドの作製工程を示す図、

【図11】本発明の近接場光ヘッドを応用した光記録再 生装置の斜視図。

【図12】図11で用いられる光ヘッド部の詳細を示す

[図3]

図3



化基基基 化电池

図。

【図13】本発明の光記録再生装置におけるサーボ動作 を説明する図。

【図14】 本発明の近接場光へッドの他の実施例を示す 図。

【図15】本発明の光記録再生装置の他の例を示す図。

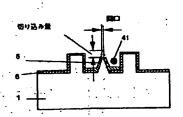
【図16】本発明のスライダーの第4の実施例を示す図。

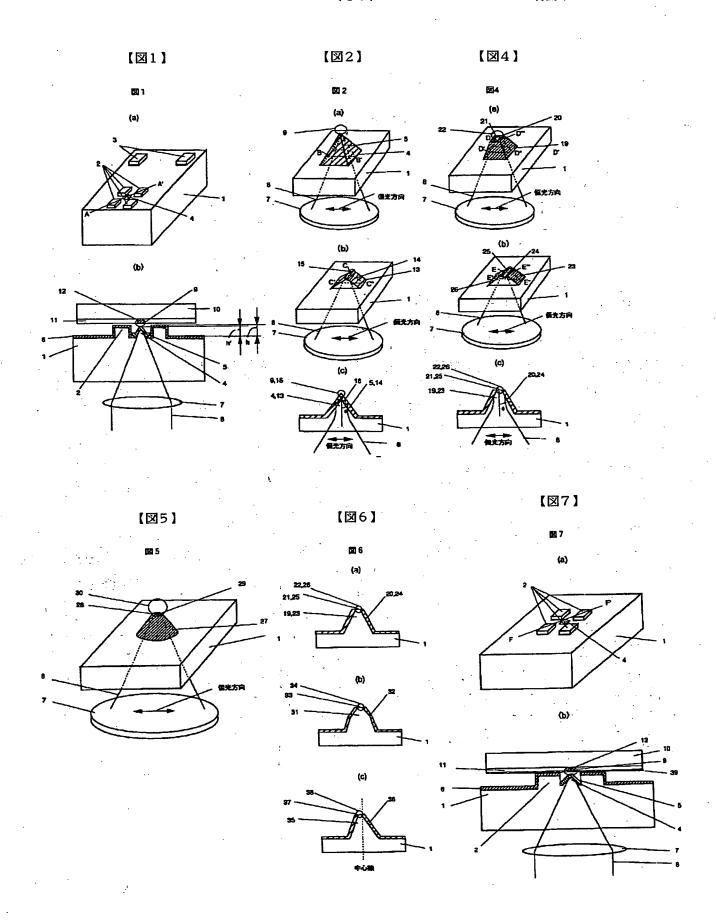
### 【符号の説明】

1…スライダ、2…パッド、3…パッド、4…プロー ブ、5…金属薄膜、6…摩耗防止用の薄膜、7…対物レ ンズ、8…半導体レーザ光、9…近接場光、10…基 板、11…記録媒体、12…記録情報、13…プロー ブ、14…金属薄膜、15…近接場光、16…表面プラ ズマ波、17…プローブ、18…金属薄膜、19…プロ ープ、20…遮光膜、21…開口、22…近接場光、2 3…プローブ、24…遮光膜、25…開口、26…近接 場光、27…プローブ、28…遮光膜、29…開口、3 0…近接場光、31…プローブ、32…遮光膜、33… 開口、34…近接場光、35…プローブ、36…連光 膜、37…開口、38…近接場光、39…摩耗防止用薄 膜、40…フォトレジスト、41…FIB、42…べー ス、43…ディスク、44…軸、45…インターフェー ス、46…コネクタ、47…システムコントローラ、4 8…可動部、4.9…アクチュエータ、50…アーム、5 1…アクチュエータ、52…サスペンション、53…光 学ヘッド、54…光学ヘッド可動部、55…半導体レー ザ、56…コリメートレンズ、57…ピームスプリッ タ、58…ガルバノミラー、59…2次元アクチュエー タ、60…レンズ、61…ビームスプリッタ、62…4 分割光検出器、63…シリンドリカルレンズ、64…4 分割光検出器、65、66、67、68、69、70、 71…情報トラック、72…アドレスマーク、73…ウ ォブルマーク、74…クロックマーク、75…情報記録 部、76…対物レンズ、77…半導体レーザ、78…対 物レンズ、79…光検出器、80…対物レンズ、81… .偏光制御素子、82…光検出器、83…パッド、84… 土台。

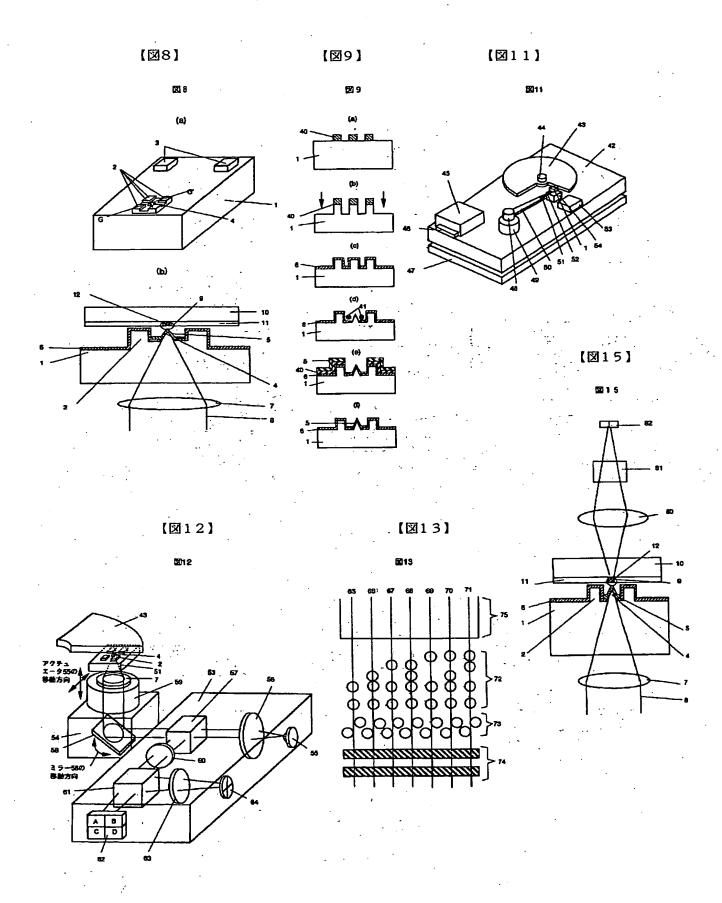
【図10】

**23**10





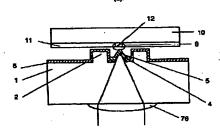
nuconoin. .in 444000000

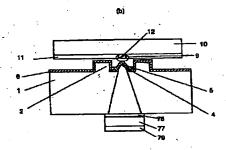


【図14】

图14

fe)

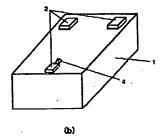


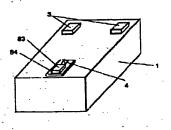


【図16】

四16

(a)





フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

器別記号

G 1 1 B 21/21

1 0 1

FΙ

G 1 1 B 21/21

101P

(72) 発明者 中村 公夫

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内